

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和7年4月16日(2025.4.16)

【国際公開番号】WO2024/024483

【出願番号】特願2024-536935(P2024-536935)

【国際特許分類】

G 0 1 N 2 1 / 8 8 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

G 0 1 N 2 1 / 9 5 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

G 0 3 F 7 / 2 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 5 K 3 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 5 K 3 / 0 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 5 K 3 / 1 8 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

G 0 3 F 7 / 4 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

10

【 F I 】

G 0 1 N 2 1 / 8 8 K

G 0 1 N 2 1 / 9 5 6 B

G 0 3 F 7 / 2 0 5 1 1

H 0 5 K 3 / 0 0 Q

H 0 5 K 3 / 0 0 V

H 0 5 K 3 / 0 6 D

H 0 5 K 3 / 1 8 D

G 0 3 F 7 / 4 0

20

【手続補正書】

【提出日】令和7年1月7日(2025.1.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

30

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

レジストパターンが形成された基板からの発光に基づいて前記レジストパターンを外観検査する外観検査工程を備える、  
レジストパターンの検査方法。

【請求項2】

前記外観検査工程では、前記基板からの発光に基づいて前記レジストパターンの輪郭を検出し、検出した前記輪郭に基づいて前記レジストパターンを外観検査する、  
請求項1に記載のレジストパターンの検査方法。

40

【請求項3】

前記外観検査工程では、検出した前記輪郭と前記レジストパターンを形成するためのパターンデータとを対比する、  
請求項2に記載のレジストパターンの検査方法。

【請求項4】

前記外観検査工程では、検出した前記輪郭に基づいて前記レジストパターンの線幅を計測する、  
請求項2に記載のレジストパターンの検査方法。

【請求項5】

前記基板上に前記レジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、

50

前記レジストパターン形成工程の後に、前記レジストパターンに発光材料を含浸させる発光材料含浸工程と、を更に備える、  
請求項 1 又は 2 に記載のレジストパターンの検査方法。

【請求項 6】

前記レジストパターン形成工程では、光と反応して発光材料に変換される化合物が含まれた前記レジストパターンを形成する、  
請求項 5 に記載のレジストパターンの検査方法。

【請求項 7】

前記レジストパターン形成工程では、 $0.05\ \mu\text{m}$ 以上 $500\ \mu\text{m}$ 以下の厚さの前記レジストパターンを形成する、  
請求項 5 に記載のレジストパターンの検査方法。

10

【請求項 8】

基板上にレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、  
前記レジストパターン形成工程の後に、前記レジストパターンに発光材料を含浸させる発光材料含浸工程と、を備える、  
レジストパターンの製造方法。

【請求項 9】

前記レジストパターン形成工程では、光と反応して発光材料に変換される化合物が含まれた前記レジストパターンを形成する、  
請求項 8 に記載のレジストパターンの製造方法。

20

【請求項 10】

前記レジストパターン形成工程では、 $0.05\ \mu\text{m}$ 以上 $500\ \mu\text{m}$ 以下の厚さの前記レジストパターンを形成する、  
請求項 8 又は 9 に記載のレジストパターンの製造方法。

【請求項 11】

レジストパターンが形成された基板からの発光に基づいて前記レジストパターンを外観検査する外観検査工程と、

前記外観検査工程における前記外観検査に基づいて前記レジストパターンを評価する評価工程と、を備える、  
基板選別方法。

30

【請求項 12】

前記評価工程では、前記レジストパターンの欠陥の数により前記レジストパターンを評価する、  
請求項 11 に記載の基板選別方法。

【請求項 13】

前記外観検査工程において外観検査する前記基板の前記レジストパターンには、発光材料が含浸されている、  
請求項 11 又は 12 に記載の基板選別方法。

【請求項 14】

請求項 11 又は 12 に記載の基板選別方法における前記レジストパターンの前記評価が基準を満たす前記基板をエッチング処理又はめっき処理して導体パターンを形成する導体パターン形成工程を備える、  
半導体パッケージ基板又はプリント配線板の製造方法。

40